
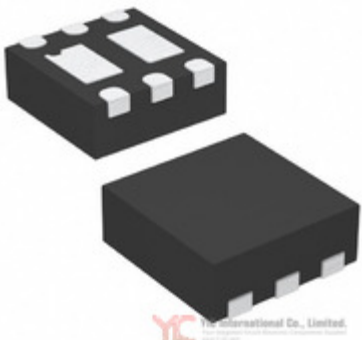



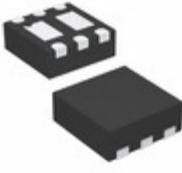


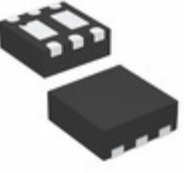

	<p>SIB912DK-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIB912DK-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6</p> <p>Datenblätter:  SIB912DK-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIB912DK-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 1.5A SC-75-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	216 mOhm @ 1.8A, 4.5V
Leistung - max	3.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-75-6L Dual
Andere Namen	SIB912DK-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	95pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 8V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 1.5A 3.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A
Basisteilenummer	SIB912

SIB912DK-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIB912DK-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIB912DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIB912DK-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIB911DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIBA 10.NH000 IGBT Module IGBT Modules</p>	 <p>SIBF-05-F-S-AD Samtec Inc. .050 SIBF ASSEMBLY</p>	 <p>SIB914DK-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 1.5A PPAK SC75-6</p>
 <p>SIB911DK-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>	 <p>SIBF-10-F-S-AD Samtec Inc. .050 SIBF ASSEMBLY</p>	 <p>SIB914DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 1.5A PPAK SC75-6</p>	 <p>SIB911DK-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.6A SC75-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIB912DK-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIB912DK-T1-GE3 Datenblatt	SIB912DK-T1-GE3-Datenblätter	SIB912DK-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIB912DK-T1-GE3
SIB912DK-T1-GE3 Electronic	SIB912DK-T1-GE3-Komponenten	SIB912DK-T1-GE3-Verteiler	SIB912DK-T1-GE3-Bild	SIB912DK-T1-GE3-Teil
SIB912DK-T1-GE3 Preis	SIB912DK-T1-GE3 Hersteller	SIB912DK-T1-GE3 Bild	SIB912DK-T1-GE3 Aktie	SIB912DK-T1-GE3 Inventar
SIB912DK-T1-GE3 Neu	SIB912DK-T1-GE3 Original	SIB912DK-T1-GE3 garantiert	SIB912DK-T1-GE3 RFQ	SIB912DK-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited